

# Silicon-Diode

## **1N663**

80V / 60mA

# DATASHEET

OEM – Texas Instruments

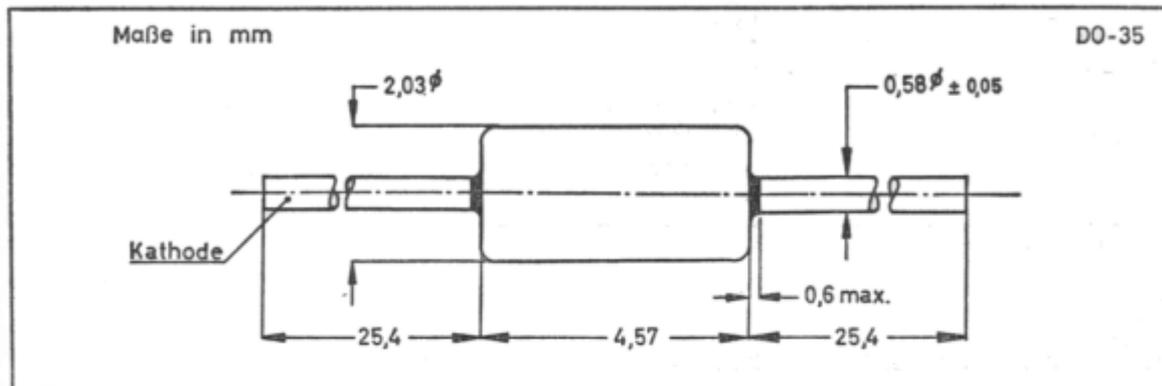
Source: Texas Instruments Databook 1968/69

## Diffundierte Silizium-Schaltodiode

1N662 und 1N663

## Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehäuse hermetisch abgeschlossen. Hochtemperatur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlüssen garantieren einen guten Kontakt, selbst bei extremsten Umweltbedingungen.



## Absolute Grenzwerte

	1N662 und 1N663
*Sperrspannung	← 80 V →
*Richtstrom bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1)	40 mA      60 mA
*Spitzenstoßstrom für die Dauer von 1 s (Bem. 2)	← 0,5 A →
*Spitzenstoßstrom für die Dauer von 0,3 s (Bem. 2)	← 1 A →
*Spitzenimpulsstrom (Bem. 3)	← 2 A →
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 4)	← 250 mW →
*Umgebungstemperatur-Arbeitsbereich	-65 °C bis +150 °C
*Lagerungstemperatur	-65 °C bis +150 °C

## Bemerkungen:

- Dieser Wert wird bei Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert. Reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C T<sub>U</sub>.
  - Dieser Wert gilt bei einem Rechteckimpuls.
  - Dieser Wert gilt für: t<sub>p</sub> ≤ 1 μs, Tastverhältnis ≤ 1%.
  - Lineare Reduzierung auf 150 °C T<sub>U</sub> mit 2 mW/°C.
- \* JEDEC registriert.

**Elektrische Kennwerte\* bei  $T_U = 25\text{ °C}$  (wenn nicht anders angegeben)**

Parameter	Prüfbedingungen	1N662		1N663		Einh.
		min	max	min	max	
$U_{(BR)}$ Durchbruchspannung	$I_R = 100\ \mu\text{A}$	100		100		V
$I_R$ Sperrstrom	$U_R = 10\ \text{V}$		1			$\mu\text{A}$
	$U_R = 50\ \text{V}$		20			$\mu\text{A}$
	$U_R = 75\ \text{V}$			5		$\mu\text{A}$
	$U_R = 10\ \text{V}, T_U = 100\text{ °C}$		20			$\mu\text{A}$
	$U_R = 50\ \text{V}, T_U = 100\text{ °C}$		100			$\mu\text{A}$
$U_F$ Flußspannung	$I_F = 10\ \text{mA}$		1			V
	$I_F = 100\ \text{mA}$			1		V

**Schaltzeit-Kennwerte\* bei  $T_U = 25\text{ °C}$  (wenn nicht anders angegeben)**

Parameter	Prüfbedingungen	1N662		1N663		Einh.
		min	max	min	max	
$t_{rr}$ Sperrverzögerungszeit	256-JAN, $I_F = 5\ \text{mA}$ , $U_R = 40\ \text{V}$ , $R_L = 2,3\ \text{k}\Omega$ , $C_L = 40\ \text{pF}$ , Erholung auf $100\ \text{k}\Omega$		0,5			$\mu\text{s}$
	256-JAN, $I_F = 5\ \text{mA}$ , $U_R = 40\ \text{V}$ , $R_L = 2,3\ \text{k}\Omega$ , $C_L = 40\ \text{pF}$ , Erholung auf $200\ \text{k}\Omega$			0,5		$\mu\text{s}$

\* JEDEC registriert.